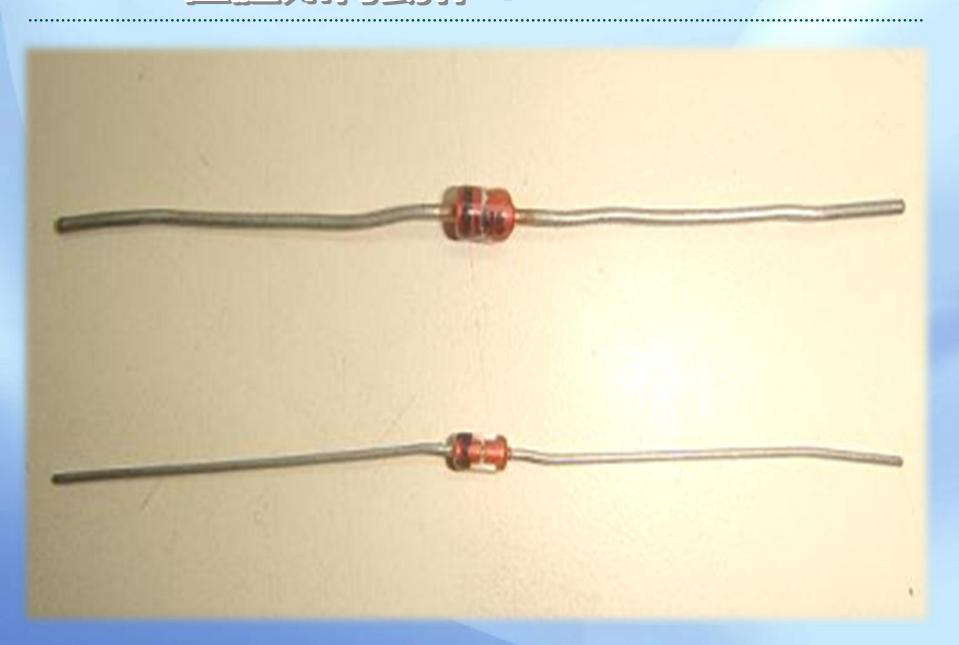
二極體

National Taiwan Normal University

講師:林宗緯







課前準備

- 有二極體的初步觀念
- 已修習過基本電學、國中物理
- 有學習的精神

課前複習

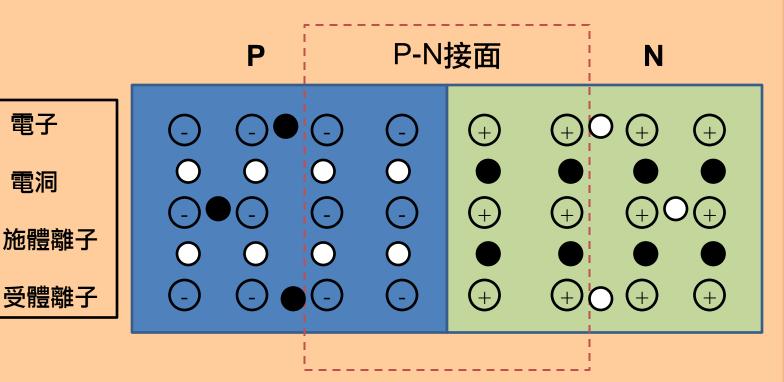
- · 二極體,一種以P-N接面所形成的基本電子元件。
- 二極,指的是多數載子為電洞(帶正電)的P極 (陽極)與多數載子為電子(帶負電)的N極(陰極)。



極體如何動作?

電洞

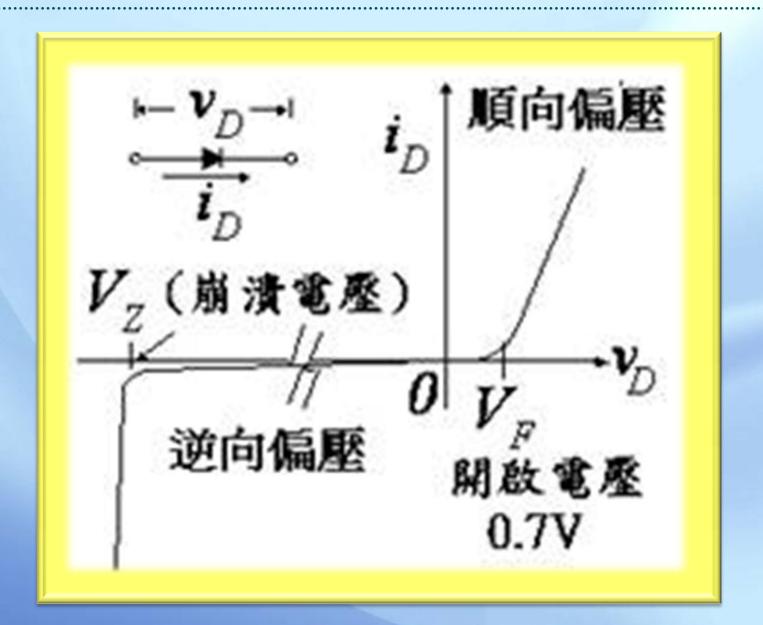
P型半導體與N型半導體連接在一起時, 在這兩個接面之間會形成所謂的P-N接面。



望 芝 區

- 載子以擴散方式移動; N型 → P型
- 電子與電洞結合抵消 (電子電洞對)
- 接合處只剩下施體離子與受體離子,沒有任何有用的載子

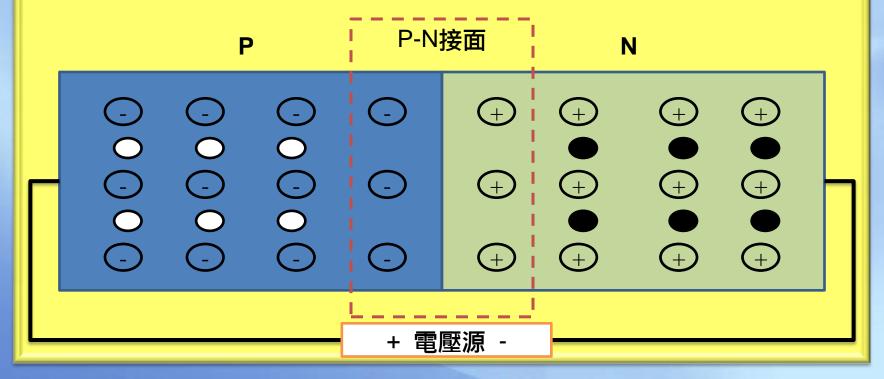
- →順向偏壓
- →逆向偏壓
- →崩潰區
- P-N 接面二極體有一特定的方向,可以讓電流較易通過,而相反方向則不易通過。
- 簡單來說,可視 P-N 接面二極體 為一電流的單行道。



順向偏壓

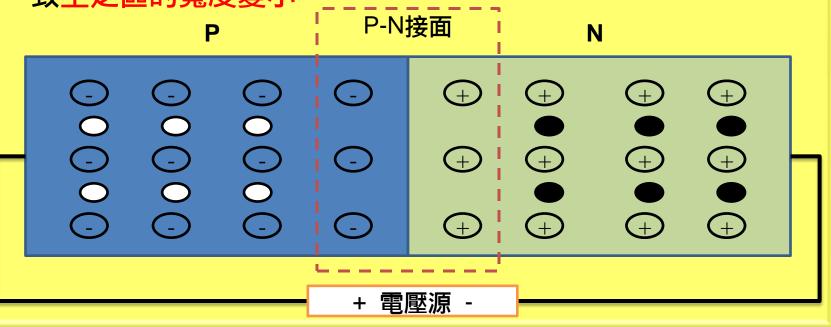
當外加電源的正端接到二級體的P極端,負端接到

二級體的N極端,這樣便形成了所謂的順向偏壓。 且外加電壓需大於障壁電壓(矽0.7V,鍺0.3V)



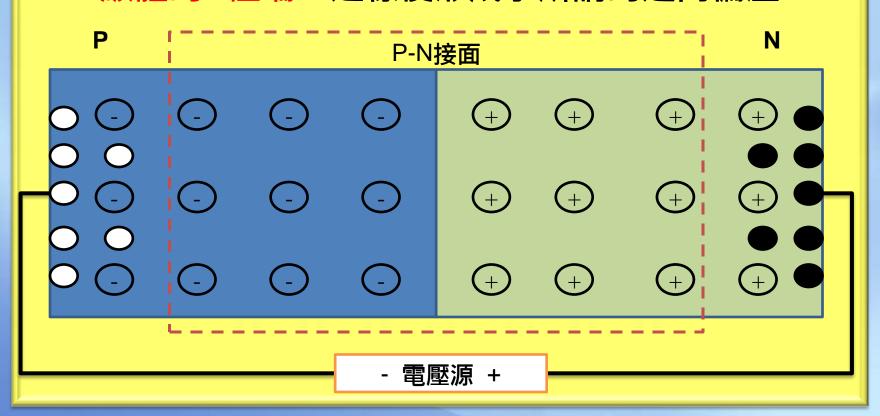
順向偏壓

- P端的多數載子電洞會與外加的正電壓互相排斥;N端的多數 載子電子也與負電壓互相排斥,導致兩者皆往空乏區方向流去。
- 電洞電子流經空乏區時,又與空乏區的正負離子結合,所以導致空乏區的寬度變小



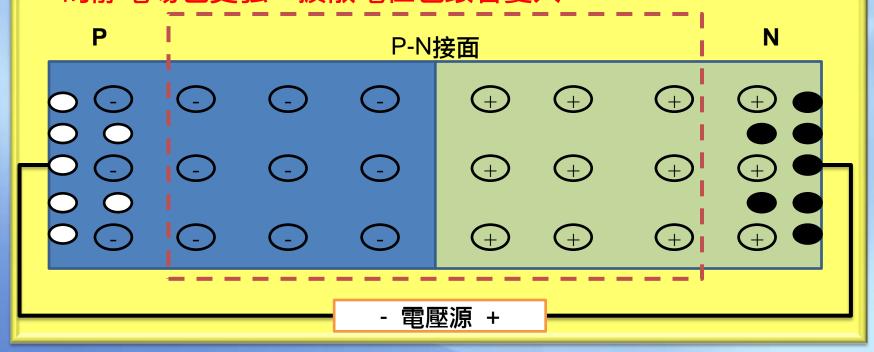
逆 向 偏 壓

當外加電源的正端接到二級體的N極端,負端接到二級體的P極端,這樣便形成了所謂的逆向偏壓。



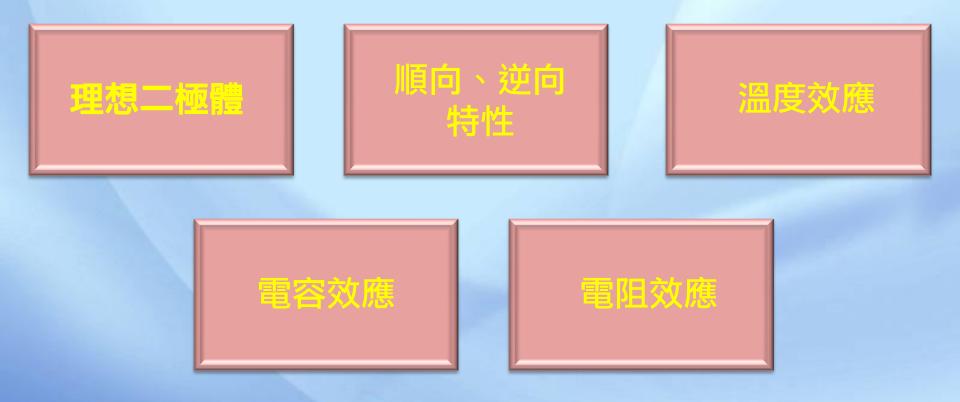
逆 向 偏 壓

- P端的多數載子電洞會被外加的負電壓吸引;N端的多數載子電子也被正電壓吸引,導致兩者皆往外接電壓方向流去。
- 主要載子變為不足,因此結合部位的空乏層變得更寬,內部 的靜電場也更強,擴散電位也跟著變大。



崩潰區

- 逆向偏壓下,外加逆向電壓超過崩潰電壓之數值
- 崩潰電壓:當外加二極體的逆向偏壓持續加大到 某一額定值時,少數載子將會大量增加,同時也 使得原本的逆向電流IS大增。
- 一般二極體在崩潰區時,由於電流增加很快,容易 產生過熱使二極體損壞。



理想二極體

針對理想二極體而言,由於不會討論到P-N接面的 障壁電位,也就是忽略空乏區的存在,因此我們

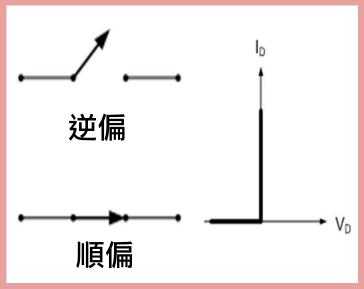
可以分析:

• 理想二極體外加偏壓時

→順向:視為短路,順向電阻=0

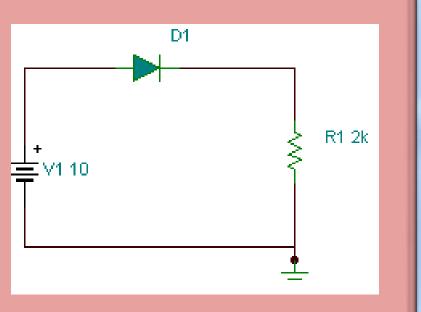
→逆向:視為開路,逆向電阻=

• 可視理想二極體如同一開關



例題一

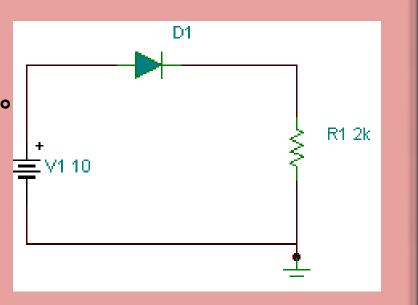
如圖之電路,假設 D1 為理想二極體,那麼流經電阻的電流應該為多少?



解答一

由於D1為理想二極體, 所以,其二極體內阻為0。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10V}{2k\Omega} = 5m(A)$$

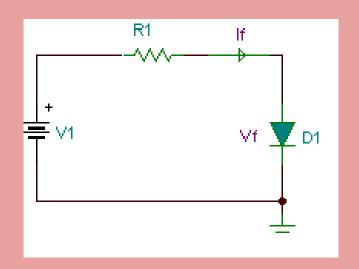


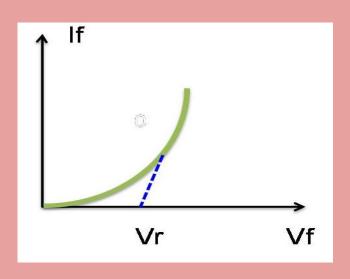
簡化二極體模型

- 使用電池、電阻、二極體等簡單元件所組成的電路, 便於分析二極體電路;這些簡易元件的組合即所謂 的等效模型,為了使電路分析可更加簡便、快速。
- 事實上,並沒有所謂的理想二極體元件,在一般實際的電路中,必須考慮到二極體的許多因素,例如順向特性、逆向特性、溫度效應等。

順向特性

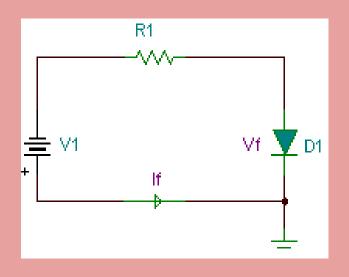
二極體接上順向偏壓後並不會馬上導通,它會一直等到電壓大於0.7V(矽)或0.3V(鍺),才會讓整個電路導通,而這個導通的電壓稱為膝點電壓或是切入電壓。

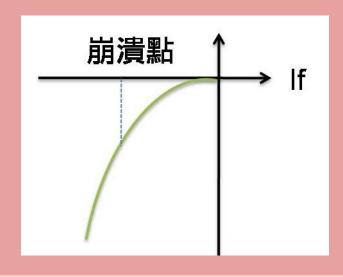




逆向特性

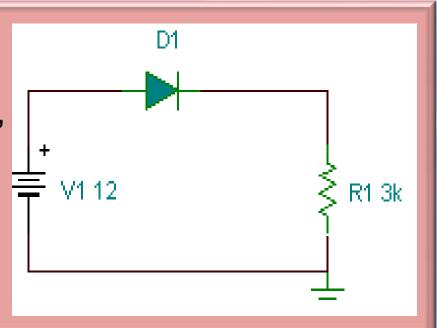
二極體接上逆向偏壓,其導通特性幾乎是不存在的,但還是有一些少數載子會流過P-N接面形成非常小的逆向飽和電流,而這些少數載子通常只會受到溫度影響。





例題二

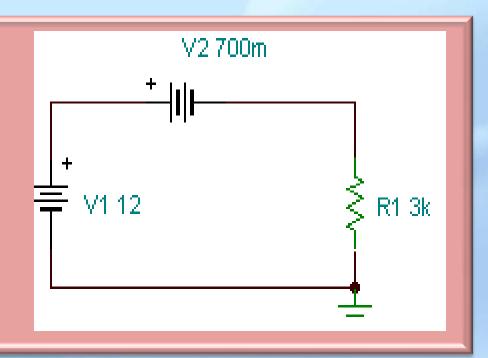
如圖之電路,當二極體 D1 切入電壓為0.7V時, 在不考慮順向電阻的情 況下,流經電阻的電流 應該為多少?



解答二

等效電路可簡化如圖

$$I = \frac{12V - 0.7V}{3k\Omega}$$
$$= 3.77 m(A)$$



溫度效應

- 二極體電流除了與外加電壓有關之外,另一個有關的因素為溫度,當周圍溫度改變時,會直接影響到二極體的切入電壓與逆向飽和電流。
- 通常矽的二極體溫度特性比鍺的好。

$$I_S(t_2) = I_S(t_1) \times 2^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

ls:逆向飽和電流, 單位 A (安培)

T1:原來溫度,單位 $^{\circ}C$

T2:上升後的溫度,單位

例題三

在室溫25度時,矽二極體逆向飽和電流 為3nA,試求出在溫度55度時,逆向飽 和電流為多少?

解答三

$$T_1 = 25^{\circ}C$$
, $T_2 = 55^{\circ}C$
 $I_{S(T_1)} = 3nA$
 $I_{S(T_2)} = I_{S(T_1)} \times 2^{\frac{T2-T1}{10}}$
55-25

 \Rightarrow $I_{S(55^{\circ}C)} = 3nA \times 2^{-10} = 24nA$

電容效應

- 二極體P-N接面的空乏區中只有正負離子,而沒有自由電 子與電洞時,可以將它看成絕緣層,而把PN兩側看做導 體,這種結構可視為一電容器。
- 二極體依偏壓方式可分為:
- →順向:擴散電容(儲存電容)

τ: 電洞的平均壽命, -般約為×10-6秒

→逆向:過渡電容(空乏區電容)

$$C_T = \varepsilon \frac{A}{d}$$

 ε : 平行板間介質的介電係數,單位F/m

A: 平行板的面積,單位 m^2

d: 兩板間的距離,單位m

C: 電容量,單位F

電阻特性

- **二極體所摻雜的雜質量與體積大小不同 →靜態電阻:外加固定的直流電壓,** 的關係,當二極體接上電路時,就會產 生出不同大小的電阻特性。
- →分布電阻:通常指二極體本身的內阻。

在外加1V電壓可求得:

$$\gamma_B = \frac{1 - 0.7}{I_F} = \frac{0.3}{I_F}$$

绪:
$$\gamma_B = \frac{1 - 0.3}{I_E} = \frac{0.7}{I_E}$$

二極體會產生一固定電阻。

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

→動態電阻:外加變動的交流電壓,

二極體會產生一變動電阻。

$$oldsymbol{\gamma}_d = rac{\Delta V_D}{\Delta I_D}igg|_{oldsymbol{ extstyle J}_{A}}$$

例題四

某一矽二極體,外加電壓為1V的順向 偏壓,測出其二極體電流為30mA,試 求出其分布電阻與靜態電阻各為多少?

解答四

分布電阻
$$\gamma_{\rm B} = \frac{1-0.7}{30 {\rm m}} = 10 \Omega$$

靜態電阻
$$R_D = \frac{1}{30m} = 33.3\Omega$$

例題五

某一二極體接上電源後,其電壓由0.3V 變化至0.5V,而電流則由15mA至45mA, 試求其動態電阻為多少?

解答五

動態電阻
$$\gamma_{\rm d} = \frac{\Delta V_{\rm D}}{\Delta I_{\rm D}} = \frac{0.5 - 0.3}{45 \text{m} - 15 \text{m}}$$

 $=6.67\Omega$